

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trương Ngọc Sơn

2. Ngày tháng năm sinh: 23/07/1982; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Bình Khánh, huyện Cần Giò, TP. Hồ Chí Minh

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 124/14/29 Võ Văn Hát, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Trương Ngọc Sơn, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, số 01, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại nhà riêng:; Điện thoại di động: 0931085929; E-mail: sontn@hcmute.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2006 đến năm 2007: Kỹ sư lập trình, nhân viên, Công ty Greystone Data System Việt Nam

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN
Từ năm 2007 đến năm 2008: Kỹ sư lập trình, nhân viên, Công ty Pyramid Software Development

Từ tháng 4 năm 2008 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng ngành; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng ngành

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ cơ quan: Số 01, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: (+84 - 028) 38968641 - (+84 - 028) 38961333 - (+84 - 028) 37221223

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không

8. Đã nghỉ hưu từ thángnăm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 05 năm 2006, ngành: Điện – Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện – Điện tử

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 03 năm 2012, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 02 năm 2016, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Kookmin, Hàn Quốc

- Được cấp bằng TSKH ngày ... tháng ... năm ..., ngành:, chuyên ngành:

.....

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm ,
ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện
- Điện tử - Tự động hóa

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Thiết kế vi mạch sử dụng linh kiện điện trở nhớ

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

- Thiết kế vi mạch thực thi các mạng nơ-ron nhân tạo và các hệ thống có hoạt động mô phỏng theo hệ thần kinh (Neuromorphic Computing System)

- Tối ưu hóa các mạng nơ-ron nhân tạo và thực thi trên vi mạch, các hệ thống lập trình được và các hệ thống nhúng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 01, cấp cơ sở ;

- Đã công bố (số lượng) 37 bài báo KH, trong đó 27 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 02 cuốn, trong đó 02 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Trong suốt thời gian làm cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tôi luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện và thực hiện đúng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo.

Về tiêu chuẩn nhà giáo:

Tôi về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm công tác giảng dạy từ tháng 4 năm 2008. Tôi bắt đầu tham gia giảng dạy từ học kỳ 1 năm học 2008-2009. Trong các năm học 2008-2009, 2009-2010 và học kỳ 1 năm học 2010-2011 tôi tham gia giảng dạy trình độ đại học các lớp lý thuyết và thực hành. Trong thời gian này tôi chưa có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn của giảng viên theo khoản e, điều 77 của luật giáo dục năm 2005, số 38/2005/QH11 và khoản 1 điều 46 của Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg năm 2003. Trong học kỳ 2 năm học 2010-2011 và học kỳ 1 năm học 2011-2012, tôi đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy trình độ đại học các lớp thực hành theo điều 24 của Điều lệ trường đại học được ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg. Từ học kỳ 2 năm học 2011-2012, tôi đã có Chứng nhận tốt nghiệp Thạc sĩ và bằng Thạc sĩ nên đủ tiêu chuẩn giảng dạy các lớp lý thuyết trình độ đại học theo Điều lệ trường đại học được ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg.

Về nhiệm vụ của nhà giáo:

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

Tôi tự đánh giá là luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhà giáo. Tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên. Tôi luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học và đối xử công bằng với người học.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):

- Tổng số 12 năm công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tôi có 7 năm tham gia giảng dạy đại học với số lượng giờ giảng dạy vượt số giờ chuẩn quy định

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2009-2010	0	0	0	12	510	0	510/735/280
2	2010-2011	0	0	0	13	528	0	528/778/280
3	2011-2012	0	0	0	11	591	0	591/801/280
3 năm học cuối								
4	2017-2018	0	0	0	12	639	0	639/759/270
5	2018-2019	0	0	2	13	630	90	720/990/270
6	2019-2020	0	0	1	10	768	0	768/938/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

- Học ĐH ; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: Hàn Quốc, năm 2016

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:số bằng:; năm cấp:.....

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, các ngành CNKT Điện tử - Viễn thông, CNKT Máy tính, Khoa Đào tạo Chất lượng cao, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Tham gia giảng dạy chương trình liên kết đào tạo quốc tế, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Đức Hải		X	X		28/08/2018 -28/02/2019	ĐHSPKT TPHCM	31/12/2019
2	Trần Thanh Hùng		X	X		28/08/2018 -28/02/2019	ĐHSPKT TPHCM	31/12/2019
3	Đoàn Huỳnh Công Sơn		X	X		28/08/2019 -28/02/2020	ĐHSPKT TPHCM	

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phản biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ luận án TS							
1	Trí tuệ nhân tạo – Cơ sở và ứng dụng	GT	NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM	01	Chủ biên		/CV_GT-ĐT
2	Ngôn ngữ lập trình C	GT	NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM	04	Chủ biên	Trang 9-44; 121-159;195-206	/CV_GT-ĐT

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 02 cuốn do nhà xuất bản uy tín xuất bản sau TS.

Lưu ý:

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- **Các chữ viết tắt:** CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
Sau khi bảo vệ luận án TS					
1	Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trở dây và thiết kế cấu trúc khử ảnh hưởng của điện trở dây trong mảng vi điện trở nhớ ứng dụng trong hệ điện toán mô phỏng hệ thần kinh	CN	T2019-59TĐ, Cấp cơ sở	01/2019 – 05/2020	23/04/2020 Xếp loại: Tốt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- **Các chữ viết tắt:** CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ								
1	Single Crossbar Array of Memristors with Bipolar Inputs for Neuromorphic Image Recognition	01	Tác giả chính	IEEE Access ISSN: 2169-3536	SCIE (IF=4.098, Q1)	1	8,1, 69327-69332	2020
2	A Low-cost Artificial Neural Network Model for Raspberry Pi	01	Tác giả chính	Engineering, Technology & Applied Science Research ISSN: 1792-8036	ESCI		10,2, 5466-5469	2020
3	A Dynamic Threshold Quantization Method for Ternary Neural Networks for Low-cost Mobile Robots	01	Tác giả chính	International Journal of Computer Science and Network Security ISSN: 1738-7906	ESCI		20,2, 16-20	2020
4	Analysis of the Impact of Wire Resistance on Nano-scale Memristor Crossbar Array Implementing Perceptron Neural Network	01	Tác giả chính	IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ISSN: 1757-899X	Scopus		Đã báo cáo, đã chấp nhận đăng.	2020

5	Optimizing the Distribution of Memristance Values of Memristive Synapses for Reducing Power Consumption in Analog Memristor Crossbar-Based Neural Networks	01	Tác giả chính	International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249-8958	Scopus, Q4, IF=0.129		9,2, 2036-2039	2019
6	Improving the Variation-Tolerance of Memristor synapses by Selecting the Optimal Memristance	01	Tác giả chính	International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878	Scopus, Q4 IF=0.158		9,2, 12028-12031	2019
7	A Parasitic Resistance-Adapted Programming Scheme for Memristor Crossbar-Based Neuromorphic Computing Systems	01	Tác giả chính	Materials ISSN: 1996-1944	SCIE (IF=2.97, Q2)	1	12,24, 1-12	2019
8	Compensating Circuit to Reduce the Impact of Wire Resistance in a Memristor Crossbar-Based Perceptron Neural Network	01	Tác giả chính	Micromachines ISSN: 2072-666X	SCIE (IF=2.426, Q2)	2	10,671, 1-11	2019
9	Memristor binarized neural networks	08		Journal of Semiconductor Technology and Science ISSN 1598-1657	SCIE (IF=0.47, Q3)	12	18,5, 568-577	2018

10	Spatial-pooling Memristor crossbar converting sensory information to Sparse Distributed Representation of Cortical Neurons	03	Tác giả chính	IEEE Transactions on Nanotechnology ISSN: 1536-125X	SCIE (IF=2.29, Q2)	6	17,3, 482-491	2018
11	In-DRAM Bitwise Processing Circuit for Low-Power and Fast Computation	04		Electronics Letters ISSN: 0013-5194	SCIE (IF=1.343, Q2)	1	53,23, 1514-1516	2017
12	Time-Shared Twin Memristor Crossbar Reducing the Number of Arrays by Half for Pattern Recognition	07	Tác giả chính	Nanoscale Research Letters ISSN: 1556-276X	SCIE (IF=3.159, Q2)	8	12,205, 1-6	2017
13	A memristor crossbar array of titanium oxide for non-volatile memory and neuromorphic applications	08		Semiconductor Science and Technology ISSN: 0268-1242	SCIE (IF=2.654, Q1)	18	32,6,1-7	2017
14	Experimental Demonstration of Sequence Recognition of Serial Memristors	07	Tác giả chính	Electronic Materials Letters ISSN: 1738-8090	SCIE (IF=1.88, Q2)	1	13,1, 86-90	2017
15	Live Demonstration: Memristor Synaptic Array with FPGA-Implemented Neurons for Neuromorphic Pattern Recognition	04	Tác giả chính	2016 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS), ISBN: 978-1-5090-1570-2 Publisher: IEEE	Scopus Scimago Journal Rank = 0.17	1	742-743	2016

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

16	Memristor Circuits and Systems for Future Computing and Bio-inspired Information Processing	04	Tác giả chính	Proceeding of 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) ISBN: 978-1-5090-2959-4 Publisher: IEEE	Scopus	2	456-459	2016
17	Sequential Memristor Crossbar for Neuromorphic Pattern Recognition	04	Tác giả chính	IEEE Transactions on Nanotechnology ISSN: 1536-125X	SCIE (IF=2.29, Q2)	12	15,6, 922-930	2016
18	Ta ₂ O ₅ -Memristor Synaptic Array with Winner-Take-All Method for Neuromorphic Pattern Matching	07	Tác giả chính	Journal of the Korean Physical Society ISSN: 0374-4884	SCIE (IF=0.63, Q3)	17	64,4, 640-646	2016
19	New pulse amplitude modulation for fine tuning of memristor synapses	06	Tác giả chính	Microelectronics Journal ISSN: 0959-8324	SCIE (IF=1.284, Q3)	12	55, 162-168	2016
20	Giảm Ảnh Hưởng Của Điện Trở Dây Trong Mạng Vi Điện Trở Nhớ Sử Dụng Mạch Khuếch Đại Vi Sai	01	Tác giả chính	Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ISSN: 1859-1531 Tạp chí được tính điểm trong HDGSNN	0-0.75 điểm		18,5.1,33-37	2020
21	Phương Pháp Mô Hình Hóa Điện Trở Dây Trong Mạng Vi Điện Trở Nhớ Ứng Dụng	01	Tác giả chính	Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật ISSN: 1859-1272	0-0.5 điểm		Chấp nhận đăng số 58, tháng 6/2020	2020

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

	Trong Mạng Nơ- Ron Nhân Tạo			Tạp chí được tính điểm trong HĐGSNN				
22	Thiết Kế Chatbot Sử Dụng Thuật Toán Khoảng Cách Levenshtein Trên Raspberry	06	Tác giả chính	Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, ISSN: 1859- 1272 Tạp chí được tính điểm trong HĐGSNN	0-0.5 điểm		Chấp nhận đăng số 60, 2020	2020
23	Thiết Kế Robot Trợ Lý Giảng Dạy Giao Tiếp Bằng Giọng Nói	02		Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Tạp chí được tính điểm trong HĐGSNN	0-0.5 điểm		Chấp nhận đăng (tháng 5, 2020)	2020
24	A Thermoelectric Energy Harvesting Circuit for A Wearable Application	04		Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers, ISSN: 1226- 7244	Tạp chí quốc tế có ISSN		21,1,66-69	2017
25	Statistical analysis on variation tolerance of time- shared Twin Memristor Crossbar for pattern matching	04	Tác giả chính	International Conference System Science and Engineering (ICSSE), ISBN: 978-1- 5386-3422-6 Publisher: IEEE	Scopus		534-537	2017
26	Reduction of Memristance Drift in Twin Memristor Crossbar	04	Tác giả chính	Proceeding of the 15th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their	Hội thảo quốc tế có phản biện và đăng toàn văn trong kỹ yếu có ISBN		63-64	2016

				Applications (CNNA), ISBN: 978-3-8007-4252-3				
27	<p>Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng dịch vụ tư vấn tự động</p> <p>Design an expert system using artificial intelligence</p>	01	Tác giả chính	<p>Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế & trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – khuyến cáo cho Thành phố Hồ Chí Minh”</p>	Hội thảo quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu		247-254	2019
Trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ								
28	FPGA-based training and recalling system for memristor synapses	06	Tác giả chính	<p>International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC)</p> <p>ISBN: 978-1-4673-8016-4</p> <p>Publisher: IEEE</p>	Scopus Scimago Journal Rank = 0.13	2	314-317	2016
29	Comparative Study on Statistical-Variation Tolerance between Complementary Crossbar and Twin Crossbar of Binary Nano-scale Memristors for Pattern Recognition	06	Tác giả chính	<p>Nanoscale Research Letters</p> <p>ISSN: 1556-276X</p>	SCIE (IF=3.159,Q2)	10	10,1, 405-413	2015
30	Process-Variation-Adaptive Charge Pump Circuit using NEM (Nano-Electro-Mechanical) Relays for Low	07		<p>Journal of Semiconductor Technology and Science</p> <p>ISSN 1598-1657</p>	SCIE (IF=0.47,Q3)	1	15,5,563-569	2015

	Power Consumption and High Power Efficiency							
31	Dynamic reference scheme with improved read voltage margin for compensating cell-position and back ground-pattern dependencies in pure memristor array	07		Journal of Semiconductor Technology and Science ISSN 1598-1657	SCIE (IF=0.47,Q3)	4	15,6, 685-694	2015
32	New twin crossbar architecture of binary memristors for low-power image recognition with discrete cosine transform	02	Tác giả chính	IEEE Transactions on Nanotechnology ISSN: 1536-125X	SCIE (IF=2.29, Q2)	21	14,6, 1104-1111	2015
33	Neuromorphic crossbar circuit with nanoscale filamentary-switching binary memristors for speech recognition	03	Tác giả chính	Nanoscale Research Letters ISSN: 1556-276X	SCIE (IF=3.159, Q2)	47	9,629,1-9	2014
34	New memristor-based crossbar array architecture with 50-% area reduction and 48-% power saving for matrix-vector multiplication of analog neuromorphic computing	02	Tác giả chính	Journal of Semiconductor Technology and Science ISSN: 1598-1657	SCIE (IF=0.47,Q3)	49	14,3, 356-363	2014
35	Memristor-based cellular nanoscale networks: Theory,	06	Tác giả chính	IEEE International Symposium on	Hội thảo quốc tế có phản biện và đăng	3	1134-1137	2015

	design and applications			Circuits and Systems (ISCAS) ISBN: 978-1-4799-8391-9 Publisher: IEEE	toàn văn trong kỹ yếu có ISBN Scimago Journal Rank = 0.29			
36	Comparative Study on Charge Pump Circuits for Harvesting Solar Energy	06		2015 International Conference on Intelligent Systems Research and Mechatronics Engineering ISSN 1951-6851, ISBN 978-94-62520-59-2	Hội thảo quốc tế có phản biện và đăng toàn văn trong kỹ yếu có ISBN		992-995	2015
37	CMOS-Memristor hybrid 4-bit multiplier circuit for energy-efficient computing	04		Journal of Institute of Korea Electrical and Electronics Engineers (IKEEE) ISSN: 1226-7244 2288-243x	Tạp chí quốc tế có ISSN	1	18,2,50-55	2014

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 17 bài

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với UV chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với UV chức danh GS.

7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
1					
2					
...					

- Trong đó, các số TT của bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
1				
2				
...				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
1					
2					
...					

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo như sau:

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Viễn thông

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Hệ thống nhúng và IoT

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

.....

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT
(UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

Haider Abbas, Yawar Abbas, **Son Ngoc Truong**, Kyeong-Sik Min, Mi Ra Park, Jongweon
Cho, Tae-Sik Yoon and Chi Jung Kang, "A memristor crossbar array of titanium oxide for
non-volatile memory and neuromorphic applications," Semiconductor Science and
Technology, vol. 32, no. 6, pp. 1-7, May 2017. (SCI, IF=2.654, SCImago index: Q1)

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác
giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác
giả chính theo quy định:

(* Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.


C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trương Ngọc Sơn